

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Handayani, N. (2007). *Analisis XRD Film Tipis $Al_xGa_{1-x}N$ diatas silikon (111) yang ditumbuhkan dengan Metode DC Magnetron Sputtering*. Skripsi pada FMIPA UNNES: diterbitkan.
- Amin, N. (2007). *Analisis Sifat Listrik Persambungan M-S-M pada film tipis $Al_xGa_{1-x}N$ yang ditumbuhkan diatas Substrat Silikon (111) dengan Metode DC Magnetron Sputtering*. Skripsi pada FMIPA UNNES: diterbitkan.
- Ariadi, E. (2006). “Studi Penumbuhan Lapisan Ta_2O_5 dengan metode DC Magnetron Sputtering untuk Lapisan Oksida dalam Struktur Metal-Oksida-Semikonduktor Al/ Ta_2O_5 /GaN.” Skripsi pada FPMIPA UNNES: diterbitkan.
- A. R. Raju, K. Sardar, C. N. R. Rao, Mater. Sci. Semicond. Proc. 4 (2001)
- Firdaus, F. (2009). *Pengaruh Molaritas Ga_2O_3 dan Laju Aliran Gas N_2 Terhadap Karakteristik fisis film tipis GaN yang ditumbuhkan dengan Metoda Sol-gel menggunakan teknik spin coating*. Skripsi pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Fong Kwong, Y. (2007). “*The Study of GaN Materials for Device Applications*”. Tesis pada Universiti Sains Malaya: diterbitkan.
- Green, B M. (2001). *Characteristics, Optimization and Integrated Circuit Application of Alumunium Gallium Nitride / Gallium Nitride High Electron Mobility Transistor, (Disertation)*. Skripsi pada Faculty of the Graduate School of Cornell University USA (18-20): tidak diterbitkan.
- Hasanah, L. *et al.* (2003). “Studi Pengaruh Rasio V/III Terhadap Morfologi Permukaan Film Tipis GaSb yang ditumbuhkan dengan Metode MOCVD Reaktor Vertikal”. Jurnal Matematika dan Sains. 8, (3), 107-109.
- Irzaman. *et al.* (2010). “Uji Konduktivitas Listrik dan Dielektrik Film Tipis Lithium Tantalate ($LiTaO_3$) yang didadah Niobium PentaOksida (Nb_2O_5) menggunakan Metoda Chemical Solution Deposition”. Prosiding Seminar Nasional Fisika 2010. 175-183.
- Karim, S. *dkk.* (2005). “Rancang Bangun Alat *Spin Coating* Sederhana untuk Penumbuhan Lapisan Tipis Semikonduktor”. Laporan Akhir Penelitian Dana Rutin UPI Tahun Anggaran 2005.

- K. Sardar, A. R. Raju, G. N. Subbanna. (2003). “*Epitaxial GaN films deposited on sapphire substrates prepared by the sol-gel method*”. Solid state Communications 125
- Kurniawan, Iwan. (2005). *Karakterisasi Sifat Fisis Film Tipis Galium Arsenat (GaAs) yang ditumbuhkan dengan Metode MOCVD*. Skripsi pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Lee, Dae-Sik et al. (2002). “GaN Thin Film as Gas Sensors, Sensors and Actuators B 89 (2003) 305-310”.
- Abdullah-Khairurrijal, M. (2010). “Karakterisasi Nanomaterial Teori, Penerapan, dan Pengolahan Data”. Bandung: CV. Rezeki Putra Bandung.
- Pankove, I. J. and Moustakas, T. (1998). *Gallium Nitride (GaN) I Semiconductors and Semimetals*. America Academic press.
- Permadi, Gian. (2008). *Pengaruh Tekanan Parsial Gas N₂ terhadap struktur kristal dan morfologi film tipis GaN yang ditumbuhkan dengan Metode PLD*. Skripsi pada FPMIPA UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Rusdiana, et al. (2001). “Penumbuhan Film Tipis GaN di Atas Substrat Sapphire dengan Teknik Sol-gel Spin Coating”.
- Sulastri, Eko. (2006). “Studi Pengaruh Rasio Laju Alir Gas Argon Dan Nitrogen Terhadap Sifat Optik Film Tipis Gallium Nitrida Yang Ditumbuhkan Dengan Metode DC Magnetron Sputtering. Semarang”. Skripsi pada FMIPA UNS: tidak diterbitkan.
- Sutanto, H. (2001). “Pengaruh Variasi Temperatur Penumbuhan Terhadap Karakteristik Sifat Listrik Film Tipis GaN di atas Si (111) dengan Metode PA-MOCVD”. Berkala Fisika. 4, (2), 40-44.
- Sutanto, H. et al. (2005). “Pengaruh Laju Aliran Gas Nitrogen Terhadap Intensitas Emisi Optik Plasma Nitrogen yang dibangkitkan oleh Gelombang Mikro 2,45 GHz dengan Metode Optical Emission Spectroscopy”. Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknologi Akselerator dan Aplikasinya. 7, 22-28.
- Sutanto, H. et al. (2006). “Karakterisasi Struktur dan Listrik Film Tipis GaN yang ditumbuhkan diatas Substrat Si (111) dengan Metode Plasma Assisted-

- Metalorganic Chemical Vapor Deposition (PA-MOCVD)". Jurnal Matematika dan Sains. 11, (1), 12-17.
- Sutanto, H. *et al.* (2008). "Penumbuhan Lapisan Tipis Semikonduktor GaN diatas Substrat Silikon dengan Metode Sol-Gel". Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Kimia dan Proses 2008.
- Tipler, Paul. (1991). *Fisika Untuk Sains dan Teknik Jilid 1* (third ed.). Jakarta: Erlangga.
- Widiyandari-Budiman, H. (2004). "Pengaruh Laju Aliran Gas N₂ terhadap Sifat Optik Film Tipis GaN yang ditumbuhkan dengan Teknik Pulsed Laser Deposition (PLD)". Berkala Fisika. 7, (1), 28-34.
- Widuri, U. (2007). *Pengaruh Tekanan Gas Argon pada Penumbuhan Film Tipis Ga₂O₃ Doping Mn dengan menggunakan metode DC Magnetron Sputtering*. Skripsi pada FPMIPA UNNES Semarang: diterbitkan.
- Y. C. Lee, Z. Hassan, F. K. Yam, M. J. Abdullah, K. Ibrahim, M. Barmawi, Sugianto, M. Budiman, P. Arifin. (2005). "A comparative study of the electrical characteristics of metal semiconductor-metal (MSM) photodiodes based on GaN grown on silicon". *Applied Surface Science*.